## Температурная зависимость одноосной магнитной анизотропии ромбоэдрических антиферромагнитных кристаллов с ионами в *S*-состоянии

## © С.Г. Овчинников, В.В. Руденко, В.И. Тугаринов

Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН, Красноярск, Россия E-mail: rvv@iph.krasn.ru

## (Поступила в Редакцию 18 февраля 2009 г. В окончательной редакции 12 мая 2009 г.)

Проведен расчет вкладов анизотропного обмена в первую и вторую константы одноосной анизотропии гематита для T = 0 K и произвольных температур. Результаты расчета, а также наиболее существенные механизмы учтены при интерпретации температурной зависимости анизотропии в ромбоэдрических антиферромагнитных кристаллах. Первая константа анизотропии гематита описывается дипольным взаимодействием, вкладами "одноионной" природы и относительно небольшими вкладами анизотропного обмена. Вторая константа гематита включает "одноионный" вклад и вклад анизотропного обмена. Основные вклады в первую константу анизотропии кристаллов FeBO<sub>3</sub> и MnCO<sub>3</sub> вносят дипольный и "одноионный" механизмы.

Теоретическая работа [1], в которой проведены расчеты анизотропии на основе двуионной модели, длительное время оставалась незамеченной экспериментаторами. Отчасти поэтому в исследовании анизотропии в методическом отношении несколько десятков лет не наблюдалось прогресса. Много позднее появились работы с привлечением эксперимента [2-4] по исследованию нового механизма "одноионной" обменной анизотропии, вытекающего из [1]. Так, при количественной оценке анизотропии в ряде магнитоконцентрированных кристаллов [3,4] с учетом "одноионного" обменного механизма снималась проблема согласия с экспериментальными данными. Однако для интерпретации температурной зависимости анизотропии, в частности, в гематите кроме "одноионного" обменного вклада и вкладов других механизмов также потребовалось проведение учета анизотропного обмена [5]. В отличие от [5] в настоящей работе получены аналитические выражения для полей анизотропии. Также установлены соотношения между константами спинового гамильтониана и эффективными полями анизотропии. Рассчитан вклад анизотропного обмена во вторую константу анизотропии гематита, отсутствующий в литературе.

В элементарной ячейке гематита две пары наиболее близко расположенных ионов железа, ось которых совпадает с  $C_3$ , обусловливают с большой точностью эффективное обменное поле этого кристалла. Об этом свидетельствуют измерения на парах Fe<sup>3+</sup> и Cr<sup>3+</sup> методом ЭПР в изоструктурном кристалле корунда [6,7].

Гамильтониан для пары ионов железа в гематите, взаимодействующих с ближайшими соседями, описывающий одноосную обменную анизотропию, в системе координат xyz, расположенный на одном из ионов, может быть представлен, согласно [1,5], в виде

$$\mathscr{H} = \sum_{j} g\beta \mathbf{H}_{j}^{\text{eff}} \mathbf{s}_{j} + A_{E} s_{z1} s_{z2} + B_{E} O_{21}^{0} O_{22}^{0} + C_{E} O_{31}^{0} O_{12}^{0}.$$
(1)

Здесь первый член представляет изотропную обменную энергию в приближении молекулярного поля, остальные члены — энергия анизотропного обмена, записанная в терминах спина и эквивалентных спиновых операторов. Считается, что изотропная обменная энергия много больше энергии анизотропных членов гамильтониана.

Найдем энергию пары ионов с точностью до первого порядка теории возмущений. Изотропную часть гамильтониана приведем к диагональному виду поворотом системы координат на углы  $\theta_j$ ,  $\varphi_j$ , задающие направление обменных полей. Гамильтониан (1) примет вид

$$\begin{split} \mathscr{H} &= \sum_{j} g\beta H_{j}^{\text{eff}} s_{zj} + A_{E} \cos \theta_{1} \cos \theta_{2} s_{z1} s_{z2} \\ &+ (B_{E}/4) (3\cos^{2}\theta_{1} - 1) (3\cos^{2}\theta_{2} - 1) O_{21}^{0} O_{22}^{0} \\ &+ (C_{E}/12) (25\cos^{3}\theta_{1} - 13\cos\theta_{1}) \cos\theta_{2} O_{31}^{0} O_{12}^{0}. \end{split}$$

Здесь опущены недиагональные члены.

Вычислим энергию. В повернутой системе координат (расположенной на ионе 1) введем углы для вектора антиферромагнетизма ( $\theta_1 = \theta$ ,  $\theta_2 = \pi - \theta$ ,  $\varphi_1 = \varphi$ ,  $\varphi_2 = \varphi + \pi$ ), положив магнитное квантовое число  $m = m_1 = -m_2$ . Считаем, что направление спинов 1 и 2 совпадает с направлением соответствующих обменных полей. Тогда нижний уровень (температура 0 K), включающий энергии нулевого и первого приближения, будет иметь вид

$$(W^{0} + W')_{m=-5/2} = -\sum_{j} g\beta |H_{j}^{\text{eff}}|s + A_{E}s^{2}\cos^{2}\theta + B_{E}s^{2}(s - 1/2)^{2}(9\cos^{4}\theta - 6\cos^{2}\theta + 1) + (C_{E}/12)s^{2}(2s^{2} - 3s + 1)(25\cos^{4}\theta - 13\cos^{2}\theta)$$

Умножая полученное выражение на N/2 (где N — число Авогадро) и сравнивая с термодинамическим

потенциалом

$$\Phi = (a/2)\cos^2\theta + (c/2)\cos^4\theta, \qquad (2)$$

запишем константы анизотропии

$$a(0) = (N)[2A_E s^2 - 12B_E s^2 (s - 1/2)^2 - (13C_E/3)s^2 (s - 1/2)(s - 1)],$$
  

$$c(0) = (N)[18B_E s^2 (s - 1/2)^2 + (25C_E/3)s^2 (s - 1/2)(s - 1)].$$

Как видно из выражений констант анизотропии, члены при  $B_E$  и  $C_E$  являются нулевыми для s = 1/2 и  $s \le 1$  соответственно.

Рассчитаем температурную зависимость констант анизотропии. Для этого запишем свободную энергию на 1 mol вещества

$$F = -(NkT) \ln \sum_{m_1m_2} \exp(-g\beta H_j^{\text{eff}} m_j/kT)$$

$$\times \exp\{(A_E/kT)m_1m_2\cos^2\theta - (B_E/4kT)$$

$$\times [3m_1^2 - s(s+1)][3m_2^2 - s(s+1)](3\cos^2\theta - 1)^2$$

$$+ (C_E/12kT)[5m_1^3 - (3s(s+1) - 1)m_1]m_2$$

$$\times (25\cos^3\theta - 13\cos\theta)\cos\theta\}.$$

Далее, разлагая свободную энергию в ряд по малому параметру (отношение констант анизотропии к kT) и суммируя по  $m_1$  и  $m_2$ , а затем сравнивая с (2), получим выражения для констант одноосной анизотропии в зависимости от температуры

$$a = (N)[(A_E/2)(z_4/z_0)^2 - 12B_E(z_1/z_0)^2 - (13C_E/4)(z_3z_4/z_0^2)],$$
  

$$c = (N)[18B_E(z_1/z_0)^2 + (25C_E/4)(z_3z_4/z_0^2)]$$

Мы запишем выражения для полей анизотропии  $H_A$ и  $H_c$  в виде температурных зависимостей эффективных полей констант второго и четвертого порядков на ионе Fe<sup>3+</sup> в гематите. При этом учтено еще одно дипольное и два выражения "одноионной" природы [1,4,8]

$$\begin{aligned} H_A &= (A'_{\rm dip} + A'_E)(z_4/5z_0) + B'_E(z_1^2/5z_0z_4) + C'_E(z_3/5z_0) \\ &+ D'_c(-z_1/z_4) + E'_c(-5z_2/z_4), \\ H_c &= -(3/2)B'_E(z_1^2/5z_0z_4) - (25/13)C'_E(z_3/5z_0) \\ &- (7/6)E'_c(-5z_2/z_4). \end{aligned}$$

Здесь коэффициенты — значения полей анизотропии при T = 0 К;  $A'_{dip}$  — дипольное поле магнитоконцентрированного кристалла, рассчитанное непосредственно; при подгонке оно берется как фиксированный параметр. Это является следствием того, что адекватность дипольных вычислений показана, например, на кристаллах MnF<sub>2</sub> при сравнении с экспериментом количественных расчетов [9] и расчетов температурной зависимости на основе спин-волновой теории [10].  $A'_E = (5/2A_E/g\beta)$  — поле анизотропного обмена (второй член гамильтониана (1));  $B'_E = -60(B_E/g\beta)$  — поле анизотропного обмена (третий член гамильтониана (1));  $C'_E = -(65/4)(C_E/g\beta)$  — поле анизотропного обмена (последний член гамильтониана (1));  $D'_c$  — суммарное "одноионное" поле анизотропии, определяемое инвариантами второго порядка [4,8] (включает вклад одноионного и "одноионного" обменного характера механизмов),  $E'_c$  — "одноионное" поле, соответствующее инвариантам четвертого порядка [4,8] и не учтенное в работе [5];

$$z_{0} = (Y^{5} + Y^{4} + Y^{3} + Y^{2} + Y + 1)/y^{5/2},$$

$$z_{1} = (-5Y^{5} + Y^{4} + 4Y^{3} + 4Y^{2} + Y - 5)/Y^{5/2},$$

$$z_{2} = (-Y^{5} + 3Y^{4} - 2Y^{3} - 2Y^{2} + 3Y - 1)/Y^{5/2},$$

$$z_{3} = (-5Y^{5} + 7Y^{4} + 4Y^{3} - 4Y^{2} - 7Y + 5)/Y^{5/2},$$

$$z_{4} = (-5Y^{5} - 3Y^{4} - Y^{3} + Y^{2} + 3Y + 5)/Y^{5/2},$$

$$Y = \exp(-2x/5);$$

$$x = (5g\beta H^{\text{eff}}/kT) = (15/7)(T_{N}/T)B_{5/2}(x),$$

 $H^{\text{eff}}$  — эффективное обменное поле на ионе Fe<sup>3+</sup>;  $B_{5/2}(x) = (z_4/5z_0)$  — функция Бриллюэна.

Полученные в численном виде и нормированные к единице при T = 0 К температурные зависимости полей анизотропии, обусловливающих  $H_A$  и  $H_c$ , совпадают с соответствующими кривыми, приведенными в [5].

В общей сложности мы использовали пять подгоночных функций. Температурные зависимости функций, описывающих анизотропный обмен и "одноионное" взаимодействие членами второго порядка, имеют достаточно схожее поведение. Поведение температурных зависимостей функций, обусловленное членами четвертого порядка (при константах  $B'_{E}$ ,  $C'_{E}$ ,  $E'_{c}$ ), также имеет аналогичный характер. Поэтому такие факторы, как погрешность эксперимента, использование функций Бриллюэна вместо намагниченности, отсутствие четких данных о температуре Нееля (мы использовали  $T_N = 972 \,\mathrm{K} \, [11]$ ), большое число подгоночных параметров, могут привести к ошибочным результатам. Для демонстрации того, что использование большого числа функций может давать неверный результат, мы подогнали Н<sub>A</sub> с использованием пяти независимых параметров. При этом мы получили решение  $A'_E = -13.00, D'_c = 10.77, C'_E = -43.99,$  $E_c' = 13.55, B_E' = 22.42$  kOe,  $\sigma_A = 0.0001$  kOe с абсолютным минимумом среднеквадратичного отклонения. Если теперь из этих данных определить  $H_c$ , то его значение будет равно 35.16 kOe при его экспериментальной величине — 0.06 kOe [12]. Поэтому мы стремились получить согласованное решение для эффективных полей первой и второй констант анизотропии гематита из температурной зависимости с использованием минимального числа подгоночных параметров. Кроме того, мы учитывали данные ЭПР, позволяющие независимым способом с использованием диамагнитных аналогов с примесью ионов магнитоконцентрированного вещества провести количественную оценку [4].



**Рис. 1.** Температурная зависимость полей одноосной анизотропии *H<sub>A</sub>* и *H<sub>c</sub>* в гематите. *а* — первый вариант подгонки, *b* — второй вариант подгонки. Точки — эксперимент [12,13], сплошные кривые — расчет.

Как показали вычисления, при использовании от трех до пяти подгоночных параметров при таком виде функций кроме абсолютного минимума для среднеквадратичного отклонения существуют локальные минимумы.

В качестве первого шага была осуществлена подгонка для поля  $H_c$  методом наименыших квадратов и получены следующие параметры:  $B'_E = -4.96$ ,  $C'_E = 5.22$ ,  $E'_c = -2.17$  kOe, а среднеквадратичное отклонение  $\sigma_c = 0.04\sigma$  kOe являлось абсолютным минимумом. Затем значения этих параметров были подставлены в выражение для  $H_A$  и определены две остальные константы  $A'_E = 0.11$ ,  $D'_c = -8.51$  kOe (при этом среднеквадратичное отклонение  $\sigma_A = 0.17$  kOe также являлось абсолютным минимумом). Отметим, что эти результаты отражают количественную оценку "одноионных" вкладов, соответствующих  $D'_c$  и  $E'_c$ : -8.5 и -0.8 kOe, определенных с помощью метода ЭПР [4]. Результаты подгонки представлены на рис. 1, a (вариант 1).

На следующем этапе сделана совместная подгонка эффективных полей первой и второй констант анизотропии методом наименыших квадратов при условии  $\sigma_A + \sigma_c = \min$ . Было получено решение для одного из локальных минимумов, также отражающее количественную оценку из данных ЭПР:  $A'_E = 3.20$ ,  $D'_c = -12.57$ ,  $C'_E = 2.64$ ,  $E'_c = -0.97$ ,  $B'_E = -2.58$  kOe,  $\sigma_A + \sigma_c = 0.05$  kOe. Результаты этой подгонки представлены на рис. 1, *b* (вариант 2).

Отметим, что подгонка теоретических кривых под экспериментальные данные ЭПР с использованием достаточного числа параметров (три параметра) показала существование для среднеквадратичного отклонения всего одного минимума [4]. Поэтому данные ЭПР являются вполне однозначными и расхождения с ними, появляющиеся при подгонке температурных зависимостей полей анизотропии, могут быть связаны с наличием указанных выше отрицательных факторов для гематита. Полученные решения (рис. 1, *a*, *b*) лишь примерно отражают значения подгоночных параметров для кристаллов гематита. Однако эти решения показывают существование вкладов анизотропного обмена в первую и вторую константы одноосной анизотропии гематита.

На рис. 2 приведена температурная зависимость одноосного поля анизотропии  $H_A$  кристаллов FeBO<sub>3</sub>. Здесь учтены дипольный и "одноионный" вклады членов второго и четвертого порядка. Подгоночными параметрами являлись "одноионные" константы  $D'_c = -0.05$  kOe и  $E'_c = -0.5$  kOe. Величина  $A'_{dip} = H_{Adip}(0) = 3.66$  kOe [16,17] использовалась как фиксированный параметр. Из данных ЭПР [4] величины, соответствующие  $D'_c$  и  $E'_c$ , равны -0.84 и -0.2 kOe.



**Рис. 2.** Температурная зависимость поля одноосной анизотропии в борате железа. Точки — эксперимент [14,15], сплошная кривая — расчет.



Рис. 3. Температурная зависимость поля одноосной анизотропии в карбонате марганца. Точки — эксперимент [18,19], сплошная кривая — расчет.

На рис. 3 представлена температурная зависимость одноосного поля анизотропии H<sub>A</sub> кристаллов MnCO<sub>3</sub>. Теоретическая температурная зависимость описывается выражениями двух механизмов: дипольного и "одноионного". При этом подгоночные параметры:  $D_{c}^{\prime} = -0.75 \, \text{kOe}$  и фиксированная величина, равная расчетному дипольному полю анизотропии,  $A'_{dip} = 3.82$  kOe. Из данных ЭПР [4] величина, включающая вклад "одноионного" механизма [4] и соответствующая  $D'_c$ , равна -0.98 kOe. На основе приведенных результатов и работ [3,4] может быть сформулирован общий метод оценки магнитной анизотропии в кристаллах с ионами в S-состоянии. Метод основан на измерении констант спинового гамильтониана одиночных и парных ионов в диамагнитных аналогах [3,4], дипольном расчете и исследовании температурной зависимости полей анизотропии в магнитоконцентрированных кристаллах.

## Список литературы

- A.E. Nikiforov, V.Ya. Mitrofanov, A.N. Men. Phys. Status Solidi B 45, 65 (1971).
- [2] О.А. Баюков, В.В. Руденко. ФТТ 34, 2665 (1992).
- [3] А.М. Воротынов, С.Г. Овчинников, В.В. Руденко, А.Н. Судаков. ФТТ 42, 1275 (2000).
- [4] V.V. Men'shikov, S.G. Ovchinnikov, V.V. Rudenko, A.N. Sudakov, V.I. Tugarinov, A.M. Vorotynov. J. Magn. Magn. Mater. 267, 289 (2003).
- [5] А.С. Москвин, И.Г. Бострем, М.А. Сидоров. ЖЭТФ 103, 2499 (1993).
- [6] Р.Л. Гарифуллина, М.М. Зарипов, В.Г. Степанов. ФТТ 12, 55 (1970).
- [7] H. Statz, L. Rimai, M.J. Weber, G.A. de Mars, G.F. Koster. J. Appl. Phys. Suppl. 32, 218S (1961).
- [8] В.Г. Лабушкин, В.В. Руденко, В.А. Саркисян, В.Н. Селезнев, А.С. Хлыстов. Тез. Всесоюз. конф. по физике магнитных явлений. Харьков (1979). С. 466.
- [9] J. Barak, V. Jaccarino, S.M. Rezende. J. Magn. Magn. Mater. 9, 323 (1978).
- [10] S.M. Rezende, A.R. King, R.M. White, J.P. Timbie. Phys. Rev. B 16, 1126 (1977).
- [11] K. Ono, A. Ito. J. Phys. Soc. Jpn. 17, 1012 (1962).
- [12] B.R. Morrison, A.H. Morrish, G.J. Troup. Phys. Status Solidi B, 56, 183 (1973).
- [13] К.С. Александров, Л.Н. Безматерных, Г.В. Козлов, С.П. Лебедев, А.А. Мухин, А.С. Прохоров. ЖЭТФ 92, 1042 (1987).
- [14] Л.В. Великанов, А.С. Прохоров, Е.Г. Рудашевский, В.Н. Селезнев. ЖЭТФ 66, 1847 (1974).
- [15] В.Г. Барьяхтар, В.Д. Дорошев, Н.М. Ковтун, В.М. Сирюк. Тез. 19-го Всесоюз. совещ. по физике низких температур. Минск (1976). С. 561.
- [16] В.В. Руденко, В.Н. Селезнев, А.С. Хлыстов. Тез. Всесоюз. конф. по физике магнитных явлений. Донецк (1981). С. 80.
- [17] В.В. Руденко, А.С. Хлыстов. Изв. вузов. Физика **42**, 82 (1999).
- [18] А.С. Боровик-Романов. В сб.: Проблемы магнетизма. Наука, М. (1972). С. 47.
- [19] Л.А. Прозорова, А.С. Боровик-Романов. ЖЭТФ 55, 1727 (1968).